

半导体学报

第3卷 第2期 1982年3月

目 录

- 用 C-V 法同时测量半导体中深中心和浅杂质的浓度分布 秦国刚 杜永昌 张玉峰 (89)
- 用 X 射线双晶及三晶衍射仪测量晶片的研磨和抛光损伤 许顺生 徐景阳 谭儒环 (95)
- 饱和电容法快速确定体产生寿命和表面产生速度 张秀森 (102)
- 应用 SEM 和 V-I 特性研究 $1.3\mu\text{m}$ InGaAsP/InP DH 激光器中掺杂的影响 葛玉如 高淑芬 王莉 汪孝杰 张盛廉 朱龙德 (107)
- DH 激光器电光延迟时间与注入脉冲电流的关系及其测量 王守武 赵礼庆 张存善 邓生贵 (113)
- LC3 型离子注入机的研制和应用 屈保春 (120)
- LSI CAD 制版中的基本单元自动选择 庄文君 (127)
- 硅中注入高剂量氮离子的研究 孙慧玲 陈鸣 王培大 (136)

研究简报

- InGaSn/Si 接触电势差的测量 徐至中 梁励芬 (141)
- 关于 ZnO 的价带结构 张光寅 (144)
- 微波无损法测半导体材料电阻率 王宗欣 赵蕙芬 胡鸣华 (147)
- Si-SiO₂-Al₂O₃ 结构的电子束辐照效应 林理彬 田景文 谢建华 陈伯英 唐方元 熊文树 林茂清 (151)
- 砷化镓掺硫气相外延 吴赛娟 仇兰华 陆大成 于清 王瑞林 (155)
- GaAs-GaAlAs DH 激光器暗线 (DLD) 的观察 陈新之 孙体忠 乔墉 (159)
- 液相外延生长 $1.3\mu\text{m}$ GaInAsP/InP 双异质结 郇祥生 杨易 李允平 唐嬭妹 水海龙 (162)
- 用于霍尔器件的 LPE-GaAs 材料 丁墨元 施益和 傅涛 王岩 李双喜 (166)